

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪ 特許出願公報

⑫ 公開特許公報(A)

昭63-205935

⑬ Int. Cl.

H 01 L 23/28
23/34

記別記号

庁内整理番号

B-6835-5F
B-6835-5F

⑭ 公開 昭和63年(1988)6月25日

審査請求 未請求 発明の枚数 1 (全3頁)

⑮ 発明の名称 放熱板付樹脂封止型半導体装置

⑯ 特 願 昭62-37850

⑰ 出 願 昭62(1987)2月23日

⑱ 発 明 者 加 藤 俊 博 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1 株式会社東芝多摩川工場内

⑲ 出 願 人 株 式 会 社 東 芝 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

⑳ 代 理 人 弁 理 士 井 上 一 男

明 細 書

1. 発明の名称

放熱板付樹脂封止型半導体装置

2. 特許請求の範囲

半導体素子を収容する放熱性の良いリードフレームのベッド部を絶縁板を介して放熱板に一体に取付け、前記半導体素子の電極とこれに不連続状態で配設する外部リード線を接続する金属層をもつ絶縁体を、前記放熱板の一部を露出して封止する樹脂層とを具備することを特徴とする放熱板付樹脂封止型半導体装置。

3. 発明の具体的な説明

(発明の目的)

(従来上の何用分野)

本発明はトランジスタアレイもしくはダイオードアレイなどを収容する放熱板付樹脂封止型半導体装置の改良に関する。

(従来の技術)

パワートランジスタ等の電力用半導体素子を絶縁に置つては熱容量が大きくかつ放熱性に劣る

だヒートシンク(放熱板を以てヒートシンクと記載する)を利用する方式が採用されており、このヒートシンクに直接半導体素子を配設する際にはアンペアが大きな問題となる。

この解決策の1つとして第2図に示す方式即ち絶縁性がありしかも高い熱伝導率を有するセールド樹脂の採用によって、半導体素板にパワートランジスタ等を貼り込んだ素子20をダイボンディングしたリードフレーム21のベッド部22とヒートシンク間に、この高熱伝導特性をもつ封止樹脂層24を通常のトランスファーマールド法によって充填する方法が実用化されている。

更に、特開昭 60-160624号公報に開示されたヒートシンクと半導体素子の分離性を図るレイハによって説明すると、先ずポリイミド、ポリアミドならびにエポキシ等の樹脂層フィルム25に接着剤26を塗布してから(図3レイ)、一定寸法に定形化したチープ27を図3開口に示す取付方式によってマウントする。このチープ27は巻取りル28ならびに引取りル28に巻き取られ、正側のヒータ

30で加熱されるヒートシンク31に、口金をボンチ32を固めるプレス33を使用してテープ22をヒートシンク31に加熱圧着方式によって固定する。その結果3図ハに明らかなように、ヒートシンク31にはテープ22を介して半導体チップ34がペースト35によって実装して、ヒートシンク31と半導体チップ34は絶縁分離する。一方、パワートランジスタやトリアック等のように電源は基板の底面からの通電が必要な場合にはテープ22にその通電部によるメタライズ配線や金属膜の付付によって電極を設け、ここにこれらの素子をダイボンディングする方法が採られている。

(発明が解決しようとする問題点)

前述の第2図に示す方式では高熱放散性と電気絶縁性を両立させるには限界があった。と云うのはリードフレームのベッド部22とヒートシンク31間の隙間を肉入で熱伝導性を確保しようとする。この隙間に充填する封止樹脂層24に空隙が発生して電気絶縁性に悪影響を生じるので、両者の間の隙間として約0.6mm以下に近づけることは事実上

無型となる。

第3図に示す素子分離方式は石炭炭素板からなるテープを折用しているが、高熱放散性が不十分で肉入すると熱抵抗が悪く、従ってパワーが大きくなると熱抵抗が大きい半導体素子の組立に問題がある。

本発明は、上記諸点を克服する最適な熱伝導性樹脂封止型半導体装置を提供することを目的とする。

(発明の構成)

(問題点を解決するための手段)

この目的を達成するために、本発明ではリードフレームのベッドに必要な二酸化ケイ素などの電子絶縁材料を敷着してからこのベッドとヒートシンク間にセラミック等の絶縁材料を介して肉入法、封止樹脂層で封止することによって、熱伝導性に優れかつ空隙抵抗の少ない樹脂封止型半導体装置を得るものである。

(作用)

このようにリードフレームのベッドとヒートシ

ンク間にセラミック等の絶縁材料を介して得られる樹脂封止型半導体装置は熱抵抗が0.5度/Wと極めて小さくなる事実を基に完成したもので、従来の技術に説明した第2図の樹脂封止型二酸化ケイ素(5000の半導体素子使用)の熱抵抗4.5度/Wに比べて肉入した面を示し、その熱伝導性は明らかである。

(実施例)

第1図により実施例を詳述するが、従来の技術と異なる点も明瞭であるが、新番号を付して説明する。

先ずリードフレーム1を用意するが、そのベッド部2に搭載する半導体素子3の形状に応じてこのリードフレーム1の型も決定されるのは当然で、ピン数の多い半導体素子3では密に肉入でデュアルインラインタイプのリードフレームを適用し、ここに半導体素子3を所定位置に実装する。次に、この半導体素子3に接続する電極とリードフレームの外装リード部を金属膜5によって接続して電気的導通を止る。ここで、

このリードフレームの材質としては制しくは銅合金を使用することを推奨しておく。この銅系リードフレームを適用しているのは、その製造時には、酸化防止に充分密着して金属膜5によるボンディング工程に支障なをよう。又ボンディング工程時にもリードフレームの酸化防止に努めるのも必要である。

次に所定の厚さの厚さを固めたヒートシンク8を用意し、その一面にペースト層9を敷着し、ここにセラミック板6を設けて一体化し、更にこのセラミック板6に矢張りペースト層の層を所7を塗って、ここに前述の通り半導体素子3を肉入した面もしくは銅合金製のリードフレームベッド部2を配置して合体する。

このセラミック板は0.6mm程度に形成し、半導体素子の大きさが6×6mm程度なら約1000円とし、材質としてはAl₂O₃、AlN、SiC、ならびにSiC等も用い得る。尚、セラミック板6の一体化に当っては石炭炭素板からなるテープの折用も使用可能である。次に、トランスフォーマーモールド成型に

この組立体を入れて、ヒートシンク8の一方の平坦面が露出するようにモールド樹脂10によって封止する。

この樹脂としては熱伝導率 $\lambda = 60 \sim 100 \times 10^{-4}$ cal/co sec であることを示す高熱導率でしかも絶縁性をもつ材料を選定した。

(発明の効果)

このように本発明に係る放熱低付絶縁防止型半導体装置ではその適用材料に熱膨張性が優れたリードフレームや封止樹脂を採用するのは勿論として、ヒートシンクと、半導体素子をマウントするリードフレームのベッド部間にセラミックを介在させて熱膨張の低減化を達成して高電力のパワーモジュールを製造したものである。

4. 図面の簡単な説明

図1図は本発明に係る放熱低付絶縁防止型半導体装置の側面を示す断面図、図2図は従来の装置の断面図、図3図イーハはヒートシンクと半導体素子の分離に絶縁シート適用例の工程を示す断面図である。

代理人 外野村 井 上 一 男

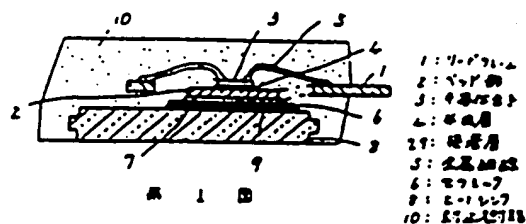


図 1 図

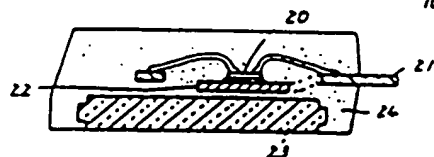


図 2 図

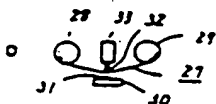


図 3 図

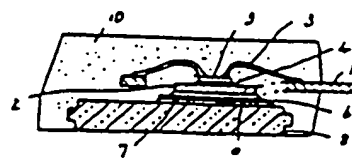
JP 363205935 A
AUG 1988

(54) RESIN-SEALED TYPE SEMICONDUCTOR DEVICE EQUIPPED WITH.
HEAT SINK

(11) 63-205935 (A) (43) 25.8.1988 (19) JP
(21) Appl. No. 62-37850 (22) 23.2.1987
(71) TOSHIBA CORP (72) TOSHIHIRO KATO
(51) Int. Cl. H01L23/28, H01L23/34

PURPOSE: To enhance the heat-dissipating performance and to reduce the ON resistance by a method wherein, after a circuit component has been mounted on a bed of a lead frame, it is fixed by laying a ceramic or the like between the bed and a heat sink so that this assembly can be resin-sealed.

CONSTITUTION: A semiconductor device 3 is fixed to a bed part 2 of a lead frame 1. Then, an electrode which has been formed on the semiconductor device 3 is connected to an external lead of the lead frame by using a metal thin wire 5. Then, a heat sink 8 is provided an Ag paste 9 is coated on one face of the heat sink a ceramic plate 6 is mounted on the face so as to be united in addition, an adhesive 7 is coated on the ceramic plate 6 the bed part 2 where the semiconductor device 3 is fixed is bonded to the ceramic plate. Then, this assembly is put in a metal mold and is sealed by using a mold resin 10 in such a way that one plane face of the heat sink 8 is exposed.



⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A)

昭63-205935

⑬ Int. Cl.

H 01 L 23/28
23/34

⑭ 特 願 昭62-37850

⑮ 出 願 昭62(1987)2月23日

⑯ 公 開 昭和63年(1988)6月25日

⑰ 審査請求 未請求 ⑱ 発明の頁 1 (全3頁)

⑲ 発明の名称 放熱板付樹脂封止型半導体装置

⑳ 特 願 昭62-37850

㉑ 出 願 昭62(1987)2月23日

㉒ 発 明 者 加 藤 俊 博 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1 株式会社東芝多摩川工場内

㉓ 出 願 人 株式会社東芝 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

㉔ 代 理 人 弁理士 井上 一男

明 細 書

1. 発明の名称

放熱板付樹脂封止型半導体装置

2. 特許請求の範囲

半導体素子を固定する放熱性の良いリードフレームのベッド部を絶縁板を介して放熱板に一体に取付け、前記半導体素子の電極とこれに不連続状態で配設する外部リード線を接続する金属細線をもつ絶縁体を、前記放熱板の一部を露出して封止する樹脂層とを具備することを特徴とする放熱板付樹脂封止型半導体装置。

3. 発明の要約

(発明の目的)

(従来の問題点)

本発明はトランジスタアレイもしくはダイオードアレイなどを有する放熱板付樹脂封止型半導体装置の改良に関する。

(従来の技術)

パワートランジスタ等の電力用半導体素子を固定するに当たっては熱容量が大きくかつ放熱性に乏し

だヒートシンク(放熱板を以てヒートシンクと記載する)を利用する方式が採用されており、このヒートシンクに直接半導体素子を配設する際にはボンディングが大きな問題となる。

この解決策の一つとして第2図に示す方式即ち絶縁性がありしかも高い熱伝導率を有するモールド樹脂の採用によって、半導体素板にパワートランジスタ等を貼り込んだ素子20をダイボンディングしたリードフレーム21のベッド部22とヒートシンク間に、この高熱伝導特性をもつ封止樹脂層24を通常のトランスファーマールド法によって充填する方法が実用化されている。

更に、特開昭 60-160624号公報に開示されたヒートシンクと半導体素子の分離性を図る構造によって説明すると、先ずポリイミド、ポリアミドならびにエポキシ等の樹脂膜フィルム23に接着剤26を塗布してから(図3参照)、一定寸法に定形化したテープ27を開口部28に示す取付方式によってマウントする。このテープ27は導電性リール29ならびに引込リール30に巻取られ、取付のヒータ

30で加熱されるヒートシンク31に、円柱をボンタ
32を備えるプレス33を使用してテープ22をヒート
シンク31に加熱圧着方式によって固定する。その
後第3図ハに明らかなように、ヒートシンク31に
はテープ22を介して半導体チップ34がペースト35
によって実装して、ヒートシンク31と半導体チッ
プ34は絶縁分離する。一方、パワートランジスタ
やトリアック等のように半導体基体の底面から
の導通が必要な場合にはテープ22に予め高導電性
によるメタライズ処理や金属膜の附付によって電極
を設け、ここにこれらの素子をダイボンディング
する方法が知られている。

(発明が解決しようとする問題点)

前述の第2図に示す方式では高熱放散性と電気
絶縁性を両立させるには限界があった。と言うの
はリードフレームのベッド部22とヒートシンク23
間の距離を肉えて高熱放散性を確保しようとする
と、この距離に充填する封止樹脂層24に空隙が
発生して電気絶縁性に悪影響を生じるので、両者の
距離として約0.6mm以下に近づけることは事実上

無理となる。

第3図に示す素子分離方式は石炭地層からな
るテープを所定しているが、高熱放散性が不十分
な熱入ると熱抵抗が低く、従ってパワーが大き
く発熱量が大きい半導体素子の組立には悪影響が
ある。

本発明は、上記諸点を克服する新規な高熱放散
性封止型半導体装置を提供することとを目的とす
る。

(発明の構成)

(問題点を解決するための手段)

この目的を達成するために、本発明ではリード
フレームのベッドに必要な半導体素子などの配子
回路部品を配置してからこのベッドとヒートシン
ク間にセラミック等の絶縁物を介して両者は、
常圧通り状態で封止することによって、熱放散性
に優れたかつ空隙抵抗の少ない絶縁封止型半導体装
置を得るものである。

(作用)

このようにリードフレームのベッドとヒートシ

ンク間にセラミック等の絶縁物を介在して得ら
れる絶縁封止型半導体装置は熱抵抗が0.5℃/Wと
極めて小さくなる事実を基に完成したもので、従
来の技術に説明した第2図の絶縁封止型半導体
装置(500口の半導体素子使用)の熱抵抗4.5℃/W
に比べて格別な低減を示し、その信頼性は明らか
である。

(実施例)

第1図により実施例を詳述するが、従来の技術
と重複する説明は図面とあるが、新番号を付し
て説明する。

先ずリードフレーム1を用意するが、そのベッ
ド部2に搭載する半導体素子3の形状に応じてこ
のリードフレーム1の型も決定されるのは当然で、
ピン数の多い半導体素子3では常法に従ってデュ
アルインラインタイプのリードフレームを適用し、
ここに半導体素子3を所定して半導体素子3をベッ
ド部2に実装する。次に、この半導体素子3に設け
る電極とリードフレームの外装リード部を金属膜
5によって接続して電気的導通をばる。ここで、

このリードフレームの材質としては銅もしくは銅
合金を使用することを推奨しておく。この銅系リ
ードフレームを適用しているの、その搬送時に
は、酸化防止に充分密着して金属腐蝕によるボ
ンディング工程に支障を来さず、又ボンディング
工程時にもリードフレームの酸化防止に努めるの
も必要である。

次に所定の半導体素子3を備えたヒートシンク
8を用意し、その一面にペースト層9を塗布し、
ここにセラミック板6を設けて一体化し、更にこ
のセラミック板6に矢張りペースト等の接着剤
7を塗布して、ここに前述の通り半導体素子3を密
着した銅もしくは銅合金製のリードフレームベッ
ド部2を配設して合体する。

このセラミック板は0.6mm程度に形成し、半導
体素子の大きさが6×6mm程度なら約1000円とし、
材質としてはAl₂O₃、AlN、SiC、ならびにSiC等何
れも適用できる。尚、セラミック板6の一体化に
あつては石炭地層を用いてガラス接着剤の使用
可である。次に、トランスフォーマー型に

この組立体を入れて、ヒートシンク8の一方の平坦な面が露出するようにモールド被膜10によって封止する。

この断面としては熱伝導率 $\lambda = 50 \sim 100 \times 10^{-4}$ cal/co sec であることを示す高熱導材でしかも絶縁性をもつ材料を選定した。

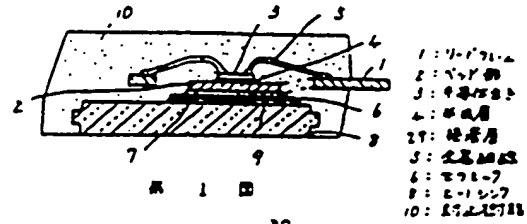
(発明の効果)

このように本発明に係る放熱低付絶縁封止型半導体装置ではその適用材料に熱放散性が優れたリードフレームや封止被膜を用いるのは勿論として、ヒートシンクと、半導体素子をマウントするリードフレームのベッド部間にセラミックを介在させて熱抵抗の低減化を達成して高電力のパワーモジュールを製造したものである。

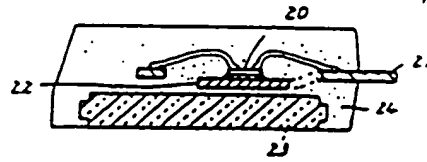
4. 実施の態様の説明

第1図は本発明に係る放熱低付絶縁封止型半導体装置の断面を示す断面図、第2図は従来装置の断面図、第3図イ〜ハはヒートシンクと半導体素子の分離に絶縁シート適用例の工程を示す断面図である。

代理人 弁理士 井 上 一 男



第 1 図



第 2 図



第 3 図